

4名の講師が解説します！

1名分料金で
2人目無料

次世代パワーデバイス技術の展望と課題

～SiC、GaN、酸化ガリウム、ダイヤモンドの最新動向～【LIVE配信】

- ◆日時: 2025年4月24日(木) 10:00～17:15
- ◆会場: 自宅や職場など世界中どこでも受講可
- ◆聴講料: 1名につき66,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

- ・1名でお申込みされた場合、1名につき55,000円(税込)
- ・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で66,000円(税込))

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

<第1部>

SiCパワーMOSFET技術の課題と最新動向

東京大学
大学院新領域創成科学研究科 教授 喜多 浩之 氏

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認ください。

- SiCパワーMOSFETへの期待
 - 1-1. パワー半導体材料としてのSiCの魅力
 - 1-2. SiCパワーMOSFETの開発状況
- SiC MOSFETとゲートスタック
- SiC表面酸化反応と表面窒化反応の理解
- SiO₂/SiC界面パッシベーション技術の展望
 - 4-1. 表面窒化効果の増大の可能性
 - 4-2. 表面酸化による悪影響の抑制の可能性
 - 4-3. 絶縁膜への異元素添加効果の理解と可能性

<第2部>

GaN系パワーデバイスの現状・課題と最新動向

名古屋大学
未来材料・システム研究所 特任准教授 田中 敦之 氏

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認ください。

- はじめに
- GaNについて
- GaN関係の動向、世界的な状況と日本の立ち位置
 - (1) パワー半導体の動向
 - (2) GaNのプレーヤー(ウェハ)
 - (3) GaNのプレーヤー(デバイス)
- GaN結晶について
- GaNパワーデバイス作製プロセスについて
- GaNパワーデバイス
- デバイス作製後のプロセス

<第3部>

酸化ガリウムの基礎とパワーデバイスの開発動向

国立研究開発法人 情報通信研究機構
グリーンICTデバイス研究室研究マネージャー 上村 崇史 氏

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認ください。

- パワーデバイスとそれを取り巻く背景
- 単結晶バルク製造技術
- エピタキシャル薄膜成長技術
- デバイス作製プロセスと要素技術
 - (ア)ショットキーコンタクト
 - (イ)イオン注入
 - (ウ)ドライ、ウェットエッチング
 - (エ)ウエハボンディング
- パワーデバイス開発
- まとめ

<第4部>ダイヤモンド半導体の特徴と開発動向

～大口径ウエハ結晶成長とパワー半導体～

佐賀大学
大学院理工学研究科 教授 嘉数 誠 氏

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認ください。

- なぜダイヤモンド半導体デバイスか パワー半導体デバイスの現状
- ダイヤモンドの物性
 - 2-1. 結晶構造
 - 2-2. 電気物性
- ダイヤモンドの結晶成長技術
- ダイヤモンド半導体デバイス技術
 - 4-1. ドーピング技術、パッシベーション技術
 - 4-2. ダイヤモンドパワー半導体作製
 - 4-3. ダイヤモンドパワー半導体のDC特性
 - 4-4. ダイヤモンドパワー半導体のパワー特性

『パワーデバイス【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

 Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>